

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ

(ダーリントン接続)

# 2SB1034

通信工業用

単位: mm

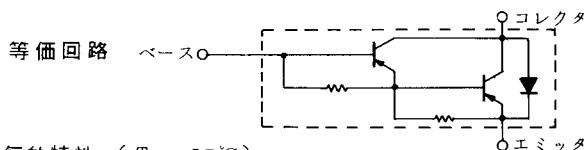
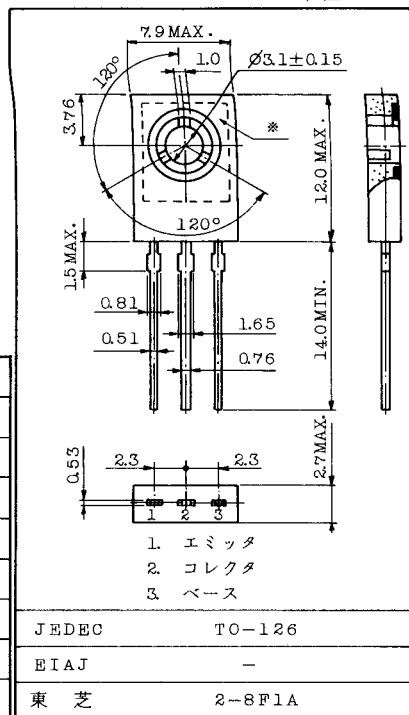
- マイクロ・モータドライブ, ハンマー・ドライブ用
- スイッチング用
- 電力増幅用

特長

- ・ 直流電流増幅率が高い。  
:  $h_{FE} = 2000$  (最小) ( $V_{CE} = -2V, I_C = -1A$ )
- ・ 飽和電圧が低い。  
:  $V_{CE(sat)} = -1.5V$  (最大) ( $I_C = -1A, I_B = -1mA$ )

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-8	V
コレクタ電流	$I_C$	-2	A
ベース電流	$I_B$	-0.5	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ C$ )	$P_C$	15	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$



\* 点線内のメタルはコレクタに接続されています。

電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位		
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -80V, I_E = 0$	-	-	-10	$\mu A$		
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -8V, I_C = 0$	-	-	-4	mA		
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-80	-	-	V		
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -1A$	2000	-	-			
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -1A, I_B = -1mA$	-	-	-1.5	V		
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -1A, I_B = -1mA$	-	-	-2.0	V		
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -2V, I_C = -0.5A$	-	50	-	MHz		
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	30	-	pF		
スイッチング時間	ターンオン時間	$t_{on}$				-	0.4	-
	蓄積時間	$t_{atg}$				-	2.0	-
	下降時間	$t_f$				-	0.4	-